

Dr. Sergei Dvoretzkiy

Adresse*	Russian Academy of Sciences Siberian Branch Rzhanov Institute of Semiconductor Physics av. Lavrent'eva, 13 630090 Novosibirsk
Fachgebiet	Physik
Spezialgebiet	Solid State Physics
persönliche Website	http://www.isp.nsc.ru

Projekte

Terahertz optoelectronics in novel low-dimensional narrow gap semiconductor nanostructures

Bewilligung: 05.12.2019

Opto-electronic and transport phenomena in narrow gap semiconductor structures for terahertz detection

Bewilligung: 28.02.2016

* letzte der Stiftung bekannte Adresse